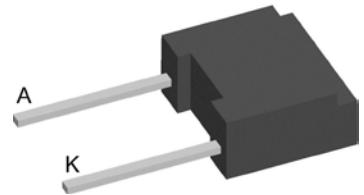


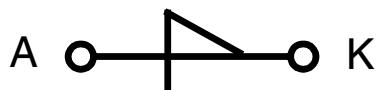
Breakover Diode Gen² (BOD2)

V_{BO} = 400-1400 V
I_{AVM} = 0.9 A

V _{BO} [V]	Standard Types
400 ±50	IXBOD2-04
500 ±50	IXBOD2-05
600 ±50	IXBOD2-06
700 ±50	IXBOD2-07
800 ±50	IXBOD2-08
900 ±50	IXBOD2-09
1000 ±50	IXBOD2-10
1100 ±50	IXBOD2-11
1200 ±50	IXBOD2-12
1300 ±50	IXBOD2-13
1400 ±50	IXBOD2-14



Backside: isolated



Features / Advantages:

- Extra fast turn-on
- Very low temperature dependance

Applications:

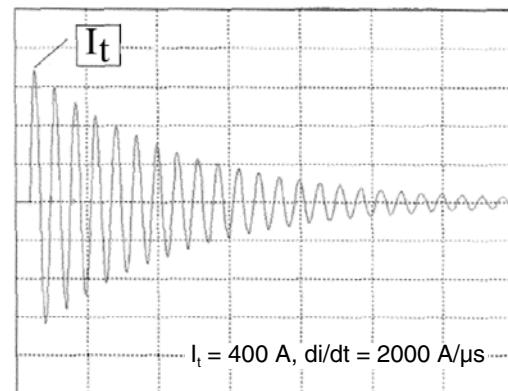
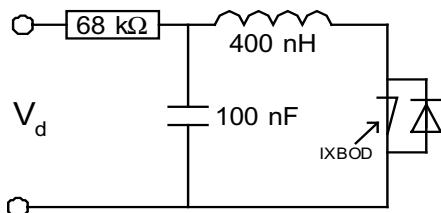
- High voltage circuit protection
- Transient voltage protection
- Trigger device
- Power pulse generators
- Lightning and arcing protection
- Energy discharge circuits
- Battery overvoltage protection
- Solar array protection

Package: FP-Case

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Base plate: Plastic overmolded tab
- Reduced weight

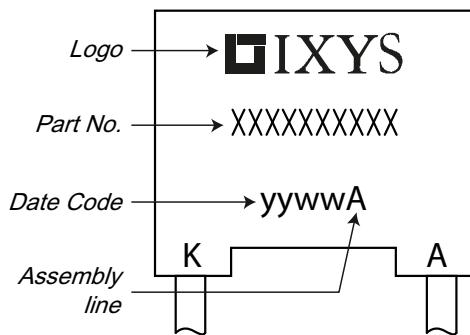
BOD2

Symbol	Definitions	Conditions	Ratings		
			min.	typ.	max.
I_D	drain current	$V_D = 0.8 \cdot V_{BO}$	$T_{VJ} = 25^\circ C$		10 μA
			$T_{VJ} = 125^\circ C$		200 μA
V_{BO}	breakover voltage	$V_{BO}(T_{VJ}) = V_{BO, 25^\circ C} [1 + K_T(T_{VJ} - 25^\circ C)]$			V
I_{RMS}	RMS current	$f = 50 \text{ Hz}$ pins soldered to printed circuit (conductor 0.035x2mm)	$T_{amb} = 50^\circ C$		1.4 A
I_{FAVM}	maximum average forward current				0.9 A
I_{SM}	maximum pulsed source current	$t_p = 0.1 \text{ ms}; \text{non repetitive}$	$T_{VJ} = 150^\circ C$		250 A
I^2t	Pt value for fusing	$t_p = 0.1 \text{ ms}$	$T_{VJ} = 150^\circ C$		3.1 A^2s
K_T	temperature coefficient of V_{BO}				$0.7 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$
K_p	coefficient for energy per pulse EP (material constant)				700 K/Ws
R_{thJA}	thermal resistance junction to ambient	natural convection with air speed 2 m/s			60 K/W 45 K/W
I_{BO}	breakover current		$T_{VJ} = 25^\circ C$		15 mA
			$T_{VJ} = 150^\circ C$		6 mA
I_H	holding current		$T_{VJ} = 25^\circ C$		20 mA
			$T_{VJ} = 150^\circ C$		12 mA
V_H	holding voltage		$T_{VJ} = 25^\circ C$	4	8 V
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V_D = 0.9 \cdot V_{BO}$	$T_{VJ} = 25^\circ C$		3000 V/ μs
			$T_{VJ} = 150^\circ C$		1000 V/ μs
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$I_T = 100 \text{ A}; V_D = V_{BO}; f = 50 \text{ Hz}$ $I_T = 600 \text{ A}; \text{non repetitive}$	$T_{VJ} = 150^\circ C$		200 A/ μs 500 A/ μs
t_q	turn-off time	$V_D = 0.75 \cdot V_{BO}; V_R = 0 \text{ V}; I_T = 100 \text{ A}$ $dv/dt_{(lin.)} = 5000 \text{ V}/\mu s; di/dt = -500 \text{ A}/\mu s$	$T_{VJ} = 125^\circ C$	200	μs
V_T	forward voltage drop	$I_T = 10 \text{ A}$	$T_{VJ} = 125^\circ C$		1.3 V
			$T_{VJ} = 150^\circ C$		1.2 V
V_{TO}	threshold voltage				0.75 V
r_T	slope resistance	for power-loss calculation only	$T_{VJ} = 150^\circ C$		0.05 Ω



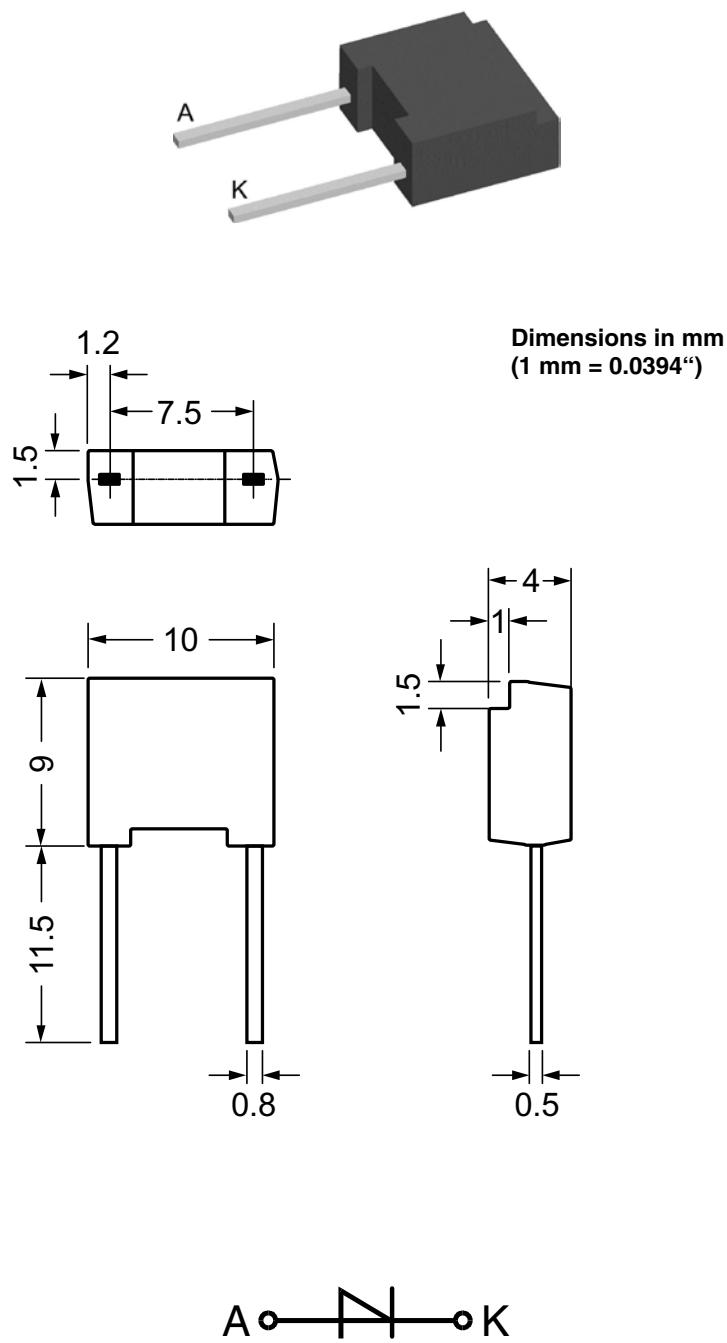
Package FP-Case			Ratings		
Symbol	Definitions	Conditions	min.	typ.	max.
T_{amb}	ambient temperature (cooling medium)		-40	150	°C
T_{stg}	storage temperature		-40	150	°C
T_{VJM}	maximum virtual junction temperature		-40	150	°C
Weight				0.9	g

Product Marking



Ordering	Part Name	Marking on Product	Delivering Mode	Base Qty	Ordering Code
Standard	IXBOD2-04	IXBOD2-04	Box	100	511174
Standard	IXBOD2-05	IXBOD2-05	Box	100	tbd
Standard	IXBOD2-06	IXBOD2-06	Box	100	tbd
Standard	IXBOD2-07	IXBOD2-07	Box	100	508425
Standard	IXBOD2-08	IXBOD2-08	Box	100	507602
Standard	IXBOD2-09	IXBOD2-09	Box	100	511668
Standard	IXBOD2-10	IXBOD2-10	Box	100	508078
Standard	IXBOD2-11	IXBOD2-11	Box	100	511860
Standard	IXBOD2-12	IXBOD2-12	Box	100	511675
Standard	IXBOD2-13	IXBOD2-13	Box	100	511682
Standard	IXBOD2-14	IXBOD2-14	Box	100	509782

Outlines FP-case



Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9